

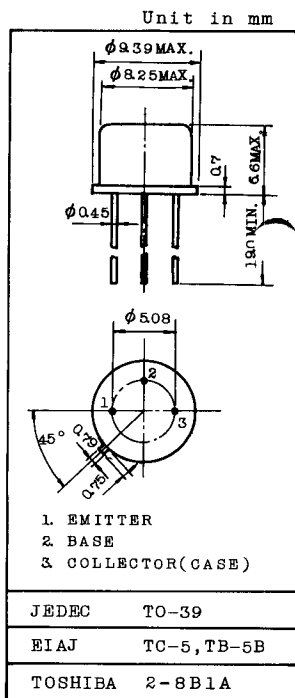
2SC497
2SC498

シリコンNPNエピタキシャル形トランジスタ(PCT方式)
SILICON NPN EPITAXIAL TRANSISTOR (PCT PROCESS)

- 中電力増幅用
- Medium Power Amplifier Applications.
- ・ 高耐圧です。 $V_{CEO} = 80V$ (2SC497)
- ・ 飽和電圧が低い $V_{CE(sat)} = 0.2V$ (Typ)
- ・ 2SA497, 2SA498 とコンプリメンタリになります。
- ・ Complementary to 2SA497 and 2SA498.

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース 間電圧	2SC497	100	V
	2SC498	80	
コレクタ・エミッタ 間電圧	2SC497	80	V
	2SC498	50	
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	5	V
コレクタ電流	I_C	800	mA
エミッタ電流	I_E	-800	mA
コレクタ損失	P_C	600	mW
接合温度	T_j	150	$^{\circ}C$
保存温度	T_{stg}	-65 ~ 150	$^{\circ}C$



※PCT 技術により製造されています。

Produced by Perfect Crystal Device Technology.

電氣的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタしや断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 30\text{V}, I_E = 0$	—	—	1.0	μA
エミッタしや断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 5\text{V}, I_C = 0$	—	—	1.0	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	2SC497	$I_C = 10\text{mA},$ $I_B = 0$	80	—	—	V
	2SC498		50	—	—	
コレクタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR) EBO}$	$I_E = 1\text{mA}, I_C = 0$	5	—	—	V
直流電流増幅率	(Note) $h_{FE(1)}$	$V_{CE} = 2\text{V}, I_C = 200\text{mA}$	40	—	240	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = 2\text{V}, I_C = 800\text{mA}$	13	—	—	
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = 10\text{V}, I_E = 10\text{mA}$	—	50	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = 10\text{V}, I_E = 0, f = 1\text{MHz}$	—	15	—	pF
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 200\text{mA}, I_B = 20\text{mA}$	—	0.2	0.8	V
ベース・エミッタ間飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = 200\text{mA}, I_B = 20\text{mA}$	—	0.8	1.2	V

Note : $h_{FE(1)}$ により下表のように分類し、現品表示してあります。

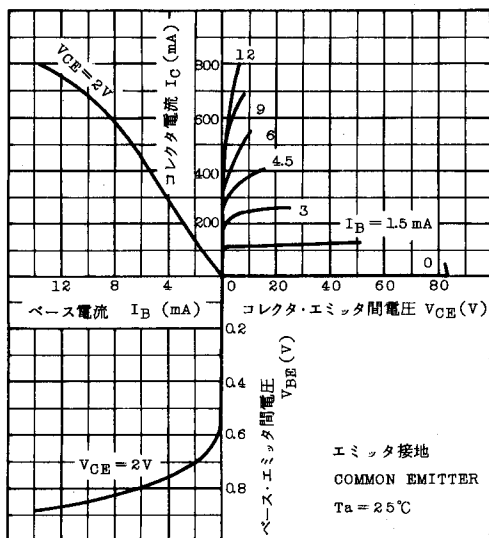
According to the value of $h_{FE(1)}$, the 2SC497 and 2SC498 are classified as follows.

CLASSIFICATION	MIN.	MAX.
2SC497 - R	40	80
2SC498 - R		
2SC497 - O	70	140
2SC498 - O		
2SC497 - Y	120	240
2SC498 - Y		

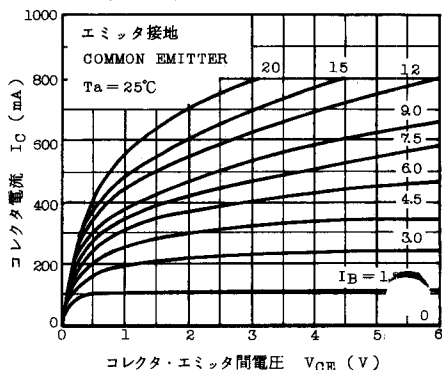
2SC497

2SC498

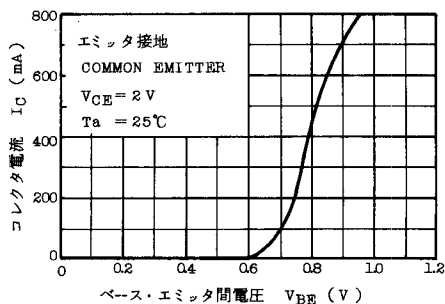
STATIC CHARACTERISTICS



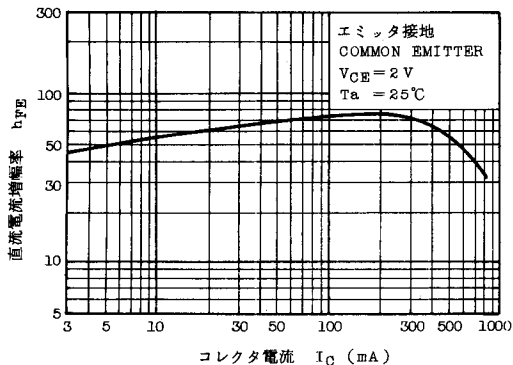
$I_C - V_{CE}$ (LOW VOLTAGE REGION)



$I_C - V_{BE}$



$h_{FE} - I_C$



$P_C - T_a$

